

概述

HM5451B 电路是一款高精度的单节内置 MOSFET 可充电锂电池的保护电路，它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流充放电保护等性能于一身。

正常状态下，HM5451B 的 VDD 端电压在过电压充电保护阈值 (V_{OC}) 和过电压放电保护阈值 (V_{OD}) 之间，且其 V_M 检测端电压在充电器检测电压 (V_{CHG}) 与过电流放电保护阈值 (V_{EDI}) 之间，此时 HM5451B 使内置 N-MOS 管导通。这时，既可以使用充电器对电池充电，也可以通过负载使电池放电。

HM5451B 通过检测 VDD 或 VM 端电压（相对于 GND 端）来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时，内置 N-MOS 由导通变为截止，从而充/放电过程停止。

HM5451B 对每种保护状态都有相应的恢复条件，当恢复条件满足以后，内置 N-MOS 由截止变为导通，从而进入正常状态。

HM5451B 对每种保护/恢复条件都设置了一定的延迟时间，只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后，才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的延迟时间以前消除，则不进入保护/恢复状态。

HM5451B 工作时功耗非常低，采用非常小的 DFN-4L(1*1*0.5)的封装，使得该芯片非常适合应用于空间限制小的可充电电池组应用。

本产品不适用与无线及射频信号排布及屏蔽太差的产品，另请客户使用本产品前务必做成品整机验证。

特性

- 单节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路
- 内置低导通内阻 N-MOSFET
- 高精度的过充电保护电压检测 $4.30V \pm 50mV$
- 高精度的过放保护电压检测 $2.8V \pm 75mV$
- 高精度过电流放电保护检测
- 电池短路保护
- 有 0V 充电
- 带有过充、过放自动恢复功能
- 低功耗 工作电流 3uA 休眠电流 0.01uA
- 超小型化的 DFN-4L(1×1×0.5)
- MOSFET:RSS(on)<72mΩ (VGS=3.7V,ID=1A)

产品应用

- 锂电池的充电、放电保护电路
- 电话机电池或其它锂电池高精度保护器

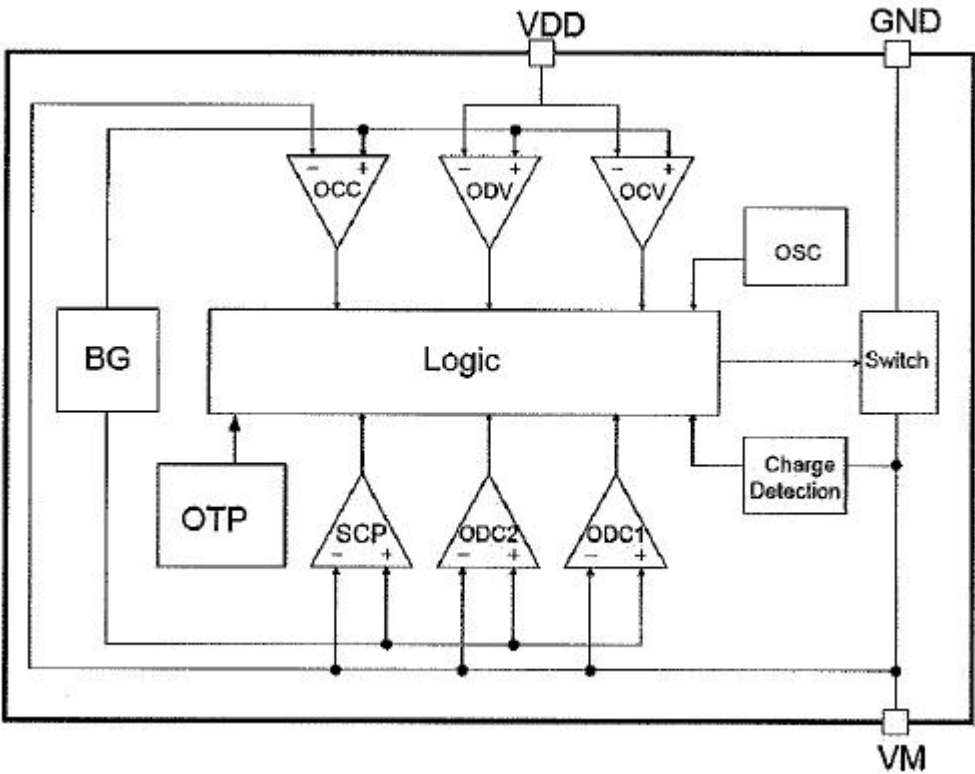
订购信息

型号	封装形式	管脚数目
HM5451B	DFN-4L(1×1×0.5)	4

引脚示意图及说明

 DFN-4L(1×1×0.5)	序号	引脚名称	I/O	说明
	1	VDD	POW	电源输入端，与供电电源（电池）的正极连接。
	2,3	GND	POW	电源接地端，与供电电源（电池）的负极相连。
	4	VM	I	充/放电电流检测输入端

功能框图



电压检测阈值及延迟时间

参数名称	HM5451B	精度范围
过电压充电保护阈值 VOCTYP	4.3V	±50mV
过电压充电恢复阈值 VOCRTYP	4.1V	±50mV
过电压放电保护阈值 VODTYP	2.8V	±100mV
过电压放电恢复阈值 VODRTYP	3.0V	±100mV
过电流放电保护阈值 VEDITYP	0.060V	±10mV
过电流充电保护阈值 VECITYP	-0.060V	±10mV
过电压充电保护延迟时间 tOCTYP	180ms	±50%
过电压放电保护延迟时间 tODTYP	50ms	±50%
过电流放电保护延迟时间 tEDITYP	10ms	±100%
过电流充电保护延迟时间 tECITYP	15ms	±100%
0V 充电功能	允许	--

极限参数

参数	符号	数值	单位
VDD 供电电源	VDD	-0.3~+10	V
VM 端允许输入电压.	VM	VDD-6~VDD+0.3	V
工作温度	T _A	-40~+85	°C
结温	--	125	°C
贮存温度	--	-55~125	°C
功耗	PD (T _A =25°C)	500	mW
封装热阻	θ _{JA}	250	°C/W
焊接温度 (锡焊, 10 秒)		260	°C
防静电保护(人体模式)	ESD	7	kV

注: 超出所列的极限参数可能导致器件的永久性损坏。以上给出的仅仅是极限范围, 在这样的极限条件下工作, 器件的技术指标将得不到保证, 长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。

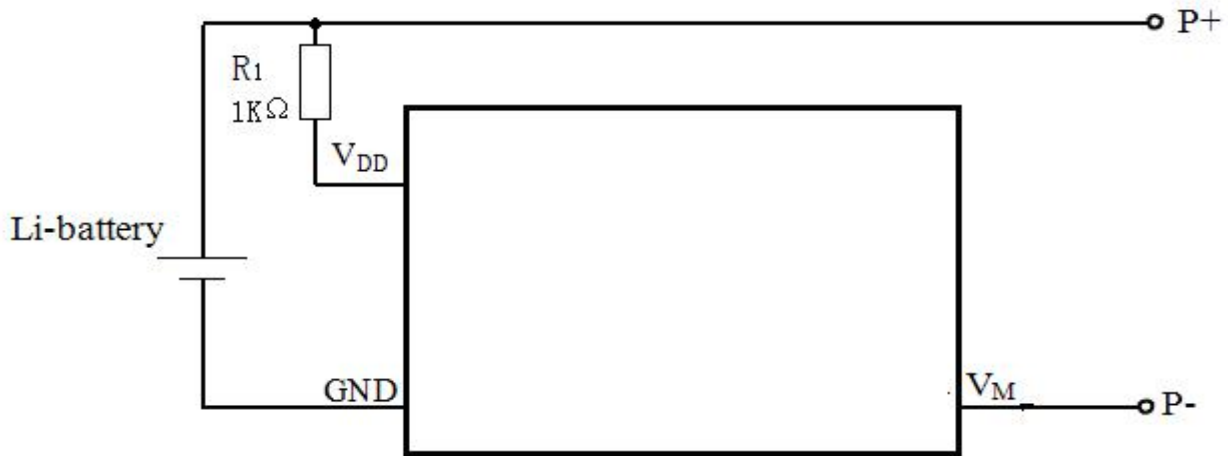
电气参数(除非特别注明, 典型值的测试条件为: $V_{DD} = 3.6V$, $T_A = 25^{\circ}C$ 。标注“■”的工作温度为: $-40^{\circ}C \leq T_A \leq 85^{\circ}C$)

参数名称	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
供电电源	V_{CC}		■	1.5		6	V
过电压充电保护阈值 (由低到高)	V_{OC}			V_{OCTYP} -0.050	V_{OCTYP}	$V_{OCTYP}+0.050$	V
			■	V_{OCTYP} -0.080	V_{OCTYP}	$V_{OCTYP}+0.080$	V
过电压充电恢复阈值 (由高到低)	V_{OCR}			V_{OCRTP} -0.050	V_{OCRTP}	$V_{OCRTP}+0.050$	V
			■	V_{OCRTP} -0.080	V_{OCRTP}	$V_{OCRTP}+0.080$	V
过电压充电保护延迟时间	t_{OC}	$V_{CC}=3.6V \rightarrow 4.5V$		$0.5 \times t_{OCTYP}$	t_{OCTYP}	$1.5 \times t_{OCTYP}$	ms
过电压放电保护阈值 (由高到低)	V_{OD}			V_{ODTYP} -0.100	V_{ODTYP}	$V_{ODTYP}+0.100$	V
			■	V_{ODTYP} -0.150	V_{ODTYP}	$V_{ODTYP}+0.150$	V
过电压放电恢复阈值 (由低到高)	V_{ODR}			$V_{ODRTY}-0.100$	V_{ODRTYP}	$V_{ODRTYP}+0.100$	V
			■	$V_{ODRTY}-0.150$	V_{ODRTYP}	$V_{ODRTYP}+0.150$	V
过电压放电保护延迟时间	t_{OD}	$V_{CC}=3.6V \rightarrow 2.4V$		$0.5 \times t_{ODTYP}$	t_{ODTYP}	$1.5 \times t_{ODTYP}$	ms
过放电电流检测	I_{lov}	$V_{DD}=3.6V$			0.9		A
过充电电流检测	I_{lcv}	$V_{DD}=3.6V$			0.9		A
过电流放电保护延迟时间	t_{EDI}				T_{EDITYP}	$2.0 \times t_{EDITYP}$	ms
过电流充电保护延迟时间	t_{ECI}				T_{ECITYP}	$2.0 \times t_{ECITYP}$	ms
负载短路检测电流	I_{SHORT}	$V_{DD}=3.6V$		7	12	20	A
电源电流	I_{CC}	$V_{CC}=3.9V$			3.0	6.0	μA
0V 充电允许电压阈值	V_{0V_CHG}	Charger Voltage		1.2			V
静态源-源极通态电阻 (VM 至 GND)	$R_{SS(ON)}$	$V_{DD}=3.7V, I_O=1A$			65	80	m Ω

注: 1. 除非特别注明, 所有电压值均相对于 GND 而言

2. 参见应用线路图

典型应用电路图



功能描述

HM5451B 是一款高精度的锂电池保护电路。正常状态下，如果对电池进行充电，则 HM5451B 可能会进入过电压充电保护状态；同时，满足一定条件后，又会恢复到正常状态。如果对电池放电，则可能会进入过电压放电保护状态或过电流放电保护状态；同时，满足一定条件后，也会恢复到正常状态。

正常状态

在正常状态下，HM5451B 由电池供电，其 VDD 端电压在过电压充电保护阈值 V_{OC} 和过电压放电保护阈值 V_{OD} 之间，VM 端电压在充电器检测电压 (V_{CHG}) 与过电流放电保护阈值 (V_{EDI}) 之间，内置 N-MOS 管导通。此时，既可以使用充电器对电池充电，也可以通过负载使电池放电。

过电压充电保护状态

➤ 保护条件

正常状态下，对电池进行充电，如果使 VDD 端电压升高超过过电压充电保护阈值 V_{OC} ，且持续时间超过过电压充电保护延迟时间 t_{OC} ，则 HM5451B 将使内置 N-MOS 管关闭，充电回路被“切断”，即 HM5451B 进入过电压充电保护状态。

➤ 恢复条件

有以下两种条件可以使 HM5451B 从过电压充电保护状态恢复到正常状态：

- 1) 电池由于“自放电”使 VDD 端电压低于过电压充电恢复阈值 V_{OCR} ；
- 2) 通过负载使电池放电（注意，此时虽然内置 N-MOS 管关闭，但由于其体内二极管的存在，使放电回路仍然存在），当 VDD 端电压低于过电压充电保护阈值 V_{OC} ，且 VM 端电压高于过电流放电保护阈值 V_{EDI} （在内置 N-MOS 管导通以前，VM 端电压将比 GND 端高一个二极管的导通压降）。

HM5451B 恢复到正常状态以后，内置 N-MOS 管回到导通状态。

过电压放电保护/低功耗状态

➤ 保护条件

正常状态下，如果电池放电使 VDD 端电压降低至过电压放电保护阈值 V_{OD} ，且持续时间超过过电压放电保护延迟时间 t_{OD} ，则 HM5451B 内置 N-MOS 管关闭，放电回路被“切断”，即 HM5451B 进入过电压放电保护状态。同时，VM 端电压将通过内部电阻 RVMD 被上拉到 VDD。

➤ 恢复条件

当充电器连接上，并且 VM 电压低于充电器检测电压 V_{CHG} 时，电池电压升高到过电压放电保护阈值 V_{OD} 以上时，HM5451B 内置 N-MOS 管导通，芯片进入正常模式。如果 VM 电压不低于充电器检测电压 V_{CHG} ，那么电池电压升高到过电压放电恢复阈值 V_{ODR} 以上时，HM5451B 内置 N-MOS 管导通，芯片进入正常模式。

过电流放电/负载短路保护状态

➤ 保护条件

正常状态下，通过负载对电池放电，T 电路的 VM 端电压将随放电电流的增加而升高。如果放电电流增加使 VM 端电压超过过电流放电保护阈值 V_{EDI} ，且持续时间超过过电流放电保护延迟时间 t_{EDI} ，则 HM5451B 进入过电流放电保护状态；如果放电电流进一步增加使 VM 端电压超过电池短路保护阈值 V_{SHORT} ，且持续时间超过短路延迟时间 t_{short} ，则 HM5451B 进入电池短路保护状态。

HM5451B 处于过电流放电/负载电池短路保护状态时，内置 N-MOS 管关闭，放电回路被“切断”；同时，VM 端将通过内部电阻 RVMS 连接到 GND，放电负载取消后，VM 端电平即变为 GND 端电平。

➤ 恢复条件

在过电流放电/电池短路保护状态下，当 VM 端电压由高降低至低于过电流放电保护阈值 V_{EDI} ，且持续时间超过过电流放电恢复延迟时间 t_{EDIR} ，则 HM5451B 可恢复到正常状态。因此，在过电流放电/电池短路保护状态下，当所有的放电负载取消后，HM5451B 即可“自恢复”。

HM5451B 恢复到正常状态以后，内置 N-MOS 回到导通状态。

过电流充电保护状态

➤ 保护条件

正常状态下，通过电源对电池充电，HM5451B 电路的 VM 端电压将随充电电流的增加而下降。如果充电电流增加使 VM 端电压超过过电流充电保护阈值 V_{ECI} ，且持续时间超过过电流充电保护延迟时间 t_{ECI} ，则 HM5451B 进入过电流充电保护状态。

➤ 恢复条件

在过电流充电保护状态下，当 VM 端电压由低升高至高于过电流充电保护阈值 V_{ECI} ，且持续时间超过过电流充电恢复延迟时间 t_{ECIR} ，则 HM5451B 可恢复到正常状态。

HM5451B 恢复到正常状态以后，内置 N-MOS 回到导通状态。

0V 电池充电

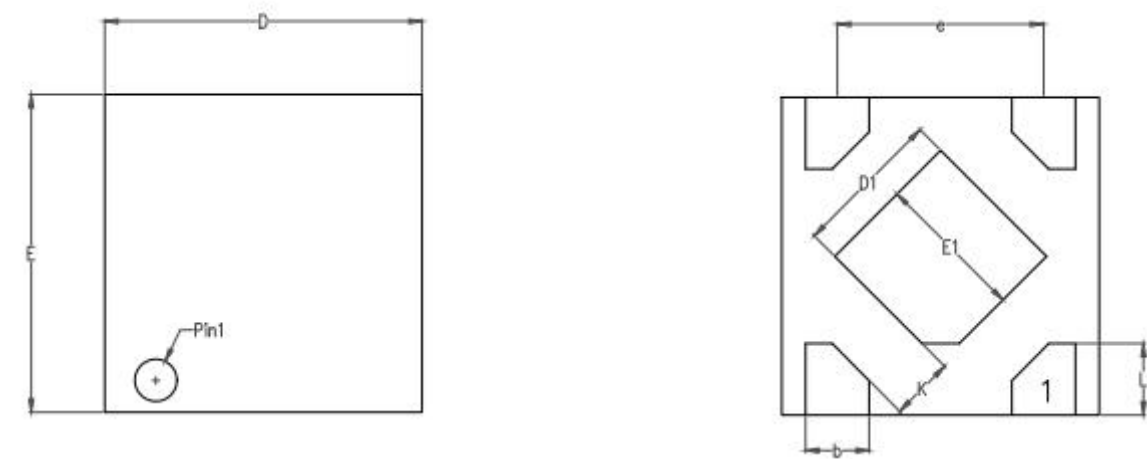
➤ 0V 电池充电允许

对于 0V 电池充电允许的电路，如果使用充电器对电池充电，使 HM5451B 电路的 VDD 端相对 VM 端的电压大于 0V 充电允许阈值 V_{0V_CHG} 时，则通过内置 N-MOS 管的体内二极管可以形成一个充电回路，使电池电压升高；当电池电压升高至使 VDD 端电压超过过电压放电保护阈值 V_{OD} 时，HM5451B 将回到正常状态，同时内置 N-MOS 回到导通状态。

注：当电池第一次接上保护电路时，可能不会进入正常模式，此时无法放电。如果产生这种现象，使 VM 管脚电压等于 GND 电压（将 VM 与 GND 短接）或连接充电器，就可以进入正常模式。

封装信息

DFN-4L(1×1×0.5)



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.45	0.50	0.55
A1	0.00	0.02	0.05
A2	0.127REF.		
b	0.15	0.20	0.25
D	0.95	1.00	1.05
E	0.95	1.00	1.05
D1	0.42	0.47	0.52
E1	0.42	0.47	0.52
e	0.60	0.65	0.70
L	0.18	0.23	0.28
K	0.15	0.20	0.25